

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年12月22日(2005.12.22)

【公表番号】特表2004-536448(P2004-536448A)

【公表日】平成16年12月2日(2004.12.2)

【年通号数】公開・登録公報2004-047

【出願番号】特願2002-583702(P2002-583702)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 21/31

C 09 K 13/08

C 23 C 14/00

C 23 C 16/44

H 01 L 21/304

H 01 L 21/3065

【F I】

H 01 L 21/31 B

C 09 K 13/08

C 23 C 14/00 Z A B B

C 23 C 16/44 J

H 01 L 21/304 6 4 5 Z

H 01 L 21/302 1 0 1 H

【手続補正書】

【提出日】平成17年3月3日(2005.3.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

4～7個の炭素原子を有するペルフルオロケトンを含む反応性ガスに堆積物を接触させることを含む、蒸気反応器から堆積物を除去する方法。

【請求項2】

4～7個の炭素原子を有するペルフルオロケトンを含むガスに誘電体材料または金属材料を接触させることを含む、蒸気反応器中で誘電体材料または金属材料をエッティングする方法。

【請求項3】

前記反応性ガスが酸素をさらに含む、請求項1又は2に記載の方法。

【請求項4】

前記反応性ガスがプラズマである、請求項1又は2に記載の方法。

【請求項5】

前記ペルフルオロケトンが5～7個の炭素原子を有する、請求項1又は2に記載の方法。
。

【請求項6】

前記ペルフルオロケトンが、CF3CF2C(O)CF2CF3、CF3C(O)CF(CC(F3)2、CF3(CCF2)2C(O)CF(CC(F3)2、(CF3)2CFC(O)CF(CC(F3)2、ペルフルオロシクロペンタノン、ペルフルオロシクロヘキサノン、およびそれらの混合物からなる群より選択される、請求項1又は2

に記載の方法。

【請求項 7】

前記誘電体材料または金属材料がシリコン系材料を含む、請求項2に記載の方法。

【請求項 8】

前記ペルフルオロケトンが約 10 未満の地球温暖化係数を有する、請求項1又は2に記載の方法。

【請求項 9】

4 ~ 7 個の炭素原子を有するペルフルオロケトンを含む反応性ガスに材料を接触させることを含む、蒸気反応器中で材料をドーピングする方法。